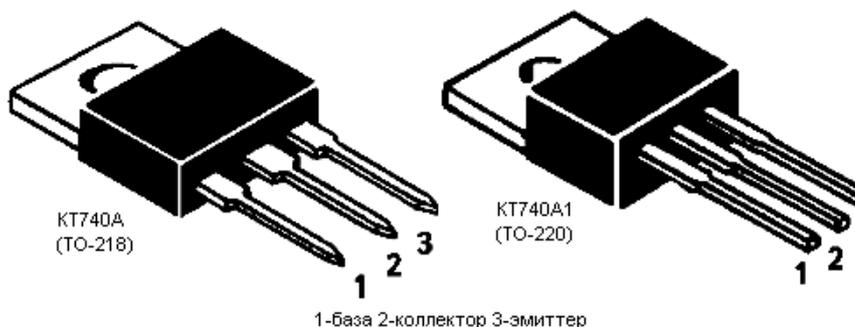


КТ740А, КТ740А1 (ШИР-2). NPN кремниевый мощный высоковольтный транзистор



Основные области применения:

- Регуляторы и преобразователи напряжения
- Импульсные переключающие схемы
- Усилители мощности для высококачественной аудиоаппаратуры

В виде кристаллов (чипов) предназначен специально для гибридных схем автомобильных регуляторов напряжения (14В)

Максимально-допустимые параметры

Наименование параметра	Обозначение	Величина	Ед.изм.
Напряжение коллектор-база	U_{CBO}	200	В
Напряжение коллектор-эмиттер ($I_B=0$)	U_{CEO}	160	В
Напряжение эмиттер-база	U_{EB}	7	В
Постоянный ток коллектора	I_C	20	А
Импульсный ток коллектора	I_{CM}	40	А
Постоянный ток базы	I_B	5	А
Постоянная рассеиваемая мощность	P_D	125*	Вт
Диапазон рабочих температур перехода	ΔT_j	-60 до +150	С
Максимальная температура перехода	$T_{j\max}$	+150	С

* - в корпусе КТ43. При сборке в корпусе КТ28(ТО-220) $P_D = 60$ Вт

Электрические характеристики

Наименование параметра, режим измерения	Обозначение	Величина		Ед. изм.
		мин.	макс.	
Граничное напряжение коллектор-эмиттер ($I_C=0.2A$)	$U_{CEO(sus)}$	160		В
Обратный ток коллектор-эмиттер ($U_{CE}=150V, I_B=0$)	I_{CEO}		0.75	мА
Обратный ток коллектор-база ($U_{CB}=200V$)	I_{CBO}		0.5	мА
Обратный ток эмиттер-база ($U_{EB}=7V$)	I_{EBO}		0.3	мА
Статический коэффициент передачи тока ($U_{CE}=4V, I_C=8A$) ($U_{CE}=4V, I_C=16A$)	h_{FE}	30 15		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_C=8A, I_B=0.8A$) ($I_C=16A, I_B=1.6A$)	$U_{CE(sat)}$		1.0 2.5	В
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_K=16A, I_B=1.6A$)	$U_{BE(sat)}$		1.7	В
Граничная частота ($I_C=1A, U_{CE}=20V$)	f_T	1.0		МГц
Емкость перехода коллектор-база ($U_{CB}=10V, I_E=0$)	C_{OB}		600	пФ

Близким зарубежным аналогом транзистора "Пир-2" является прибор МJE4343 фирмы MOTOROLA. Ориентировочная оптовая цена на II кв. 1999 г. - 12 руб. 30 коп. (в корпусе ТО-220).